

나노종합기술원 "12인치 반도체 공정" 장비 이용료 기준표 (2023년. 3월1일)

※ 장비이용료는 공정조건에 따라서 차이가 발생할 수 있습니다.

번호	연구 장비		장비이용료 기준		재료비	비고
	장비명(모델명)	공정 및 조건	이용자 직접 진행	NNFC 담당자 진행		
1	ArF immersion (ASML, XT1900Gi)	Expoure		1,500,000원/기본료+250,000원/wf		. Special 공정조건 별도
2	Track (TEL, Lithius-Pro-i)	Coating + Development		200,000원/기본료+30,000원/wf	100,000원/wf (BARC포함)	
3	CD SEM (Hitachi, CG6300)	CD Measurement		400,000원/회/60분		
4	Dielectric Etch System (Lam, 2300e5 Platform Flex)	Dielectric Etch(Non pattern)		200,000원/기본료+200,000원/wf		. Etch Depth 1um 초과 별도 . Special Material/Wafer, Plasma 내식성 평가 별도
		Dielectric Etch(pattern)		200,000원/기본료+300,000원/wf		
5	PR Strip (PSK, SUPRA N)	PR ashing		40,000원/기본료+ 40,000원/wf		
6	Oxidation (TERA, 300SE)	Thermal oxidation		1,050,000원/ 1FOUP		. 두께 2,000A 기준 . 두께 2,000A 이상 : 100,000원/1000Å 추가
		Anneal		1,050,000원/ 1FOUP		. 5시간 이상 별도
7	LPCVD (DJ-1224VN)	Nitride		1,530,000원/ 1FOUP		. 두께 1,000A 기준 . 두께 1,000A 이상 : 500,000원/1000Å 추가
8	Single wafer cleaner (PSM-302)	SC-1 Clean		50,000원/wf		
		DHF Clean		50,000원/wf		
		BOE(LAL 15) Clean		50,000원/wf		. BOE 재료비: 10,000원/Wafer
		DSP Clean		50,000원/wf		
9	PECVD (AMT, Producer SE)	Oxide ($\leq 5\mu\text{m}$)		210,000원/wf		. 두께 1.5 μm 이상 : 210,000원 추가 /1.5 μm
		Nitride ($\leq 5\mu\text{m}$)		210,000원/wf		
		Oxynitride ($\leq 5\mu\text{m}$)		210,000원/wf		
		TEOS ($\leq 5\mu\text{m}$)		210,000원/wf		
		ACL 500nm 이하		210,000원/wf		. 두께 0.5 μm 기준 . 두께 0.5 μm 이상 : 210,000원 추가 /0.5 μm
10	Spectroscopic Ellipsometer (KLA, SFX-200)	Film Thickness Measure	100,000원/기본료+40,000원/wf	130,000원/기본료+50,000원/wf		. 10장까지 / 13Point 기준
11	Defect Inspection System (AEGIS-DP)	Job file(Recipe creation)		500,000원/RUN		
		Particle 측정		200,000원/wf(10분)		